

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**



ПРОГРАММА И ПРИГЛАШЕНИЕ

**IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**МИКРО- И НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ЭЛЕКТРОНИКЕ**

**29 мая–3 июня 2017 г.
Нальчик, Россия**

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной научно-технической конференции «**Микро- и нанотехнологии в электронике**», которая пройдет с **29 мая по 3 июня 2017 года** в пос. Эльбрус на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабардино-Балкарского государственного университета (ЭУНК КБГУ). Оргкомитет желает всем участникам конференции плодотворной работы и приятного отдыха в Приэльбрусье.

Регистрация участников конференции будет проходить 29 мая с 12 до 22 часов и 30 мая с 9 до 11 часов в холле Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ по адресу пос. Эльбрус, ЭУНК КБГУ.

Продолжительность пленарных докладов до 30 минут. Продолжительность секционных устных докладов 10–15 минут. Объем стендовых докладов не регламентируется. Если у Вас есть пожелания изменить предлагаемую оргкомитетом форму доклада (устный/стендовый), то на месте возможны изменения.

Просим сообщить куда, когда и каким видом транспорта Вы прибываете на конференцию. Наши телефоны есть в информационном сообщении.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Сопредседатели:

Ю.К. Альтудов д.т.н., проф., ректор КБГУ, Нальчик

Б.С. Карамурзов д.т.н., проф., академик РАО, президент КБГУ, Нальчик

О.Н. Крохин д.ф.-м.н., проф., академик РАН, зав. каф. полупроводниковой квантовой электроники НИЯУ МИФИ, Москва

В.А. Быков, д.т.н., проф., президент Нанотехнологического общества России, генеральный директор НТ-МДТ, Москва

Зам. председателя

А.М. Кармоков д.ф.-м.н., проф. каф. электроники и информационных технологий КБГУ, Нальчик

Ученый секретарь

О.А. Молоканов к.т.н., доцент КБГУ, Нальчик

Члены программного комитета

Н.Н. Герасименко д.ф.-м.н., проф. НИУ МИЭТ, Москва

А.М. Гуляев д.т.н., проф. НИУ МЭИ, Москва

И. К. Камиллов д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН, Институт физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН, Махачкала

Н.И. Каргин д.т.н., проф., проректор НИЯУ МИФИ, Москва

В.В. Лучинин д.т.н., проф., зав. каф. микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», директор Центра микротехнологии и диагностики, Санкт-Петербург

С.С. Рагимов д.ф.-м.н., проф., Институт физики Национальной Академии наук Азербайджана, Баку

С.И. Рембеза д.ф.-м.н., проф., ВГТУ, Воронеж

Б.И. Селезнев д.т.н., проф., зав. каф. физики твердого тела и микроэлектроники НовГУ, Великий Новгород

А.Г. Смирнов д.т.н., проф. Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минск

Ю.К. Старцев д.ф.-м.н., проф. СПбГТИ (ТУ), Санкт-Петербург

Р.Ш. Тешев зав. каф. электроники и информационных технологий КБГУ, Нальчик

А.А. Шебзухов д.ф.-м.н., проф., зав. каф. физических основ микро- и наноэлектроники КБГУ, Нальчик

Dr. H.Orth Gesellschaft fur Schwerionenforschung mbh, Драмштадт, Германия

Dr. Johann Marton Stefan Meyer Institut, Вена, Австрия

Научная программа работы

IX Международной научно-технической конференции

«Микро- и нанотехнологии в электронике»

29 мая – 3 июня

12:00–22:00 Регистрация участников конференции и размещение в гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

13:00 Обед

14:00 Прогулки по окрестностям ЭУНК КБГУ

30 мая, вторник

9:00–11:00 Регистрация участников конференции и размещение в гостинице (холл ЭУНК КБГУ, пос. Эльбрус)

11:00 Открытие конференции (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Вступительное слово: **Альтудов Юрий Камбулатович** – д.т.н., проф., ректор КБГУ, Нальчик

Приветственное слово: **Камиллов Ибрагимхан Камиллович** – д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН, Дагестанский научный центр. РАН, Махачкала

Приветственное слово: **Быков Виктор Александрович** – д.т.н., проф., ген. директор ЗАО «Нанотехнология МДТ», Президент Нанотехнологического общества России, Москва

Кофе-пауза (холл ЭУНК КБГУ)

11:30 Утреннее заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Пленарная сессия

Председатели: **Альтудов Юрий Камбулатович** – д.т.н., проф., ректор Кабардино-Балкарского государственного университета, Нальчик;

Камиллов Ибрагимхан Камиллович — д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН, Институт физики, им. Х.И. Амирханова Дагестанского НЦ РАН, Махачкала

1. Нанопорядоченные полупроводники — материалы опережающие время. *Академик Академии электротехнических наук РФ Попов А.И. (Москва)*
2. Важнейшие вехи в развитии физики фазовых переходов и критических явлений в конденсированных средах. *Член-корр. РАН Камиллов И.К. (Махачкала)*

3. Спин-волновые возбуждения в гексагональных цилиндрических ферромагнитных нанотрубках. *Танрывердиев В.А., Тагиев В.С., Керимова Г.Г. (Баку)*
4. Специфика преподавания дисциплины “Микроэлектронные датчики и сенсорные устройства”. *Родионов Ю.А. (Минск)*
5. Вакуумные и твердотельные преобразователи ИК-изображений на пироэлектриках. *Кармоков А.М., Молоканов О.А., Платов Э.А. (Нальчик)*

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 1. Физика и химия материалов и структур микро- и наноэлектроники

Председатели: **Шебзухов Азамат Аюбович** д.ф.-м.н., проф., зав. каф. физических основ микро- и наноэлектроники, Нальчик;
Мирошникова Ирина Николаевна – д.т.н., проф., директор института радиотехники и электроники, НИУ «МЭИ», Москва.

Устные доклады

1. Гистограммный подход к нормировке рентгеновских дифракционных картин монокристаллических материалов. *Князева М.А., Бронвальд Ю.А., Босак А.А., Бурковский Р.Г., Андроникова Д.А., Литягин Г.А., Вахрушев С.Б., Политова Г.А., Филимонов А.В.*
2. Новый подход к объяснению деформации микрокристаллов галогенида серебра под действием света. *Азизов И.К., Цитинова А.Х., Шериева Э.Х.*
3. Об уравнении состояния нанокристалла. *Магомедов М.Н.*
4. Application of carbon nanotubes in nanoelectronics. *Fediuk R.S., Smoliakov A.K., Timokhin R.A.*
5. Возможные механизмы формирования структуры наночастиц углерода при кавитационном синтезе. *Воропаев С.А., Днестровский А.Ю., Шкинев В.М., Пономарева Е.А., Душенко Н.В.*
6. Экспериментальное определение параметров граничных состояний МДП-структур. *Гусалов А.И., Датиев М.К., Датиев К.М., Дзитоева А.Г.*
7. Влияние теллура на критическую температуру $\text{FeSe}_{0,82}$. *Рагимов С.С., Курбанов Ш.Дж.*
8. Электрофизические свойства AgSbSeTe . *Рагимов С.С., Алиева А.И., Саддинова А.А.*
9. Влияние режима синтеза на флуктуационную проводимость $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_x$. *Рагимов С.С., Агаева Г.И.*
10. Соединения типа Tl9LnTe6 - новый класс термоэлектрических материалов с аномально низкой теплопроводностью. *Мехдиева И.Ф., Имамалиева С.З., Мирзоева Р.Дж., Бабанлы М.Б.*

11. Формирование диссипативных нанообъектов между квинтетными пакетами кристаллов типа $\text{A}^{\text{V}}_2\text{B}^{\text{VI}}_3$ <примесь>. *Абдуллаев Н.А., Кахраманов К.Ш., Кахраманов С.Ш., Мурсакулов Н.Н.*
12. Кристаллическая структура и электрические свойства нового соединения Cu_4SeTe . *Азизова К.К., Бабаева А.Е., Алиева М.Х., Амирасланов И.Р.*
13. Измерение магнитоэлектрического эффекта в композитных материалах на основе бидоменных пьезоэлектриков LiNbO_3 . *Турутин А.В., Жоао V. Vidal, Кубасов И.В., Малинкович М.Д., Пархоменко Ю.Н., Кобелева С.П., Холкин А.Л., Соболев Н.А.*
14. Особенности процесса коалесценции наночастиц металлов различной геометрии. *Колосов А.Ю., Мясниченко В.С., Соколов Д.Н., Сдобняков Н.Ю.*
15. Формирование фаз Лавеса в ультратонких биметаллических пленках: влияние размерного несоответствия. *Мясниченко В.С., Колосов А.Ю., Соколов Д.Н., Сдобняков Н.Ю.*
16. Комплексное исследование фрактальных свойств пленок золота: атомно-силовая и туннельная микроскопия. *Антонов А.С., Самсонов В.М., Сдобняков Н.Ю., Дьякова Е.В., Кузнецова Ю.В.*
17. Получение и рентгенографическое исследование нового интеркалята ромбического GaInS_3 с молекулами этилендиамина. *Рагимли А.Б., Алиева Е.Р., Амирасланов И.Р.*
18. Моделирование кривой спада фотопроводимости в монокристаллическом кремнии. *Анфимов И.М., Егоров Д.С., Кобелева С.П., Пыльнев А.В., Щемеров И.В., Юрчук С.Ю.*
19. Индуцированное высоким давлением отрицательное магнетосопротивление в $p\text{-CdSb:Mn}$. *Джамамедов Р.Г., Арсланов Т.Р., Кочура А.В.*
20. Электрические и магнитные свойства $\text{Cd}_3\text{As}_2+\text{MnAs}$ при высоком давлении. *Моллаев А.Ю., Сайпулаева Л.А., Алибеков А.Г., Маренкин С.Ф., Федорченко И.В.*
21. Структурная и химическая модификации аморфных алмазоподобных кремний-углеродных пленок. *Баринев А.Д., Попов А.И., Пресняков М.Ю., Шупегин М.Л.*
22. Радиационная модификация поверхностной структуры боросиликатных материалов. *Меликова С.З., Агаев Т.Н.*
23. Радиационно-каталитические процессы получения водорода из смеси $n\text{-ZrO}_2+n\text{-Al}_2\text{O}_3+\text{H}_2\text{O}$. *Агаев Т.Н., Меликова С.З.*
24. Процессы релаксации электронов в полупроводниковой квантовой яме с модифицированным потенциалом Пешля-Теллера. *Бабаев М.М., Султанова Х.Б., Мустафаев Н.Б.*
25. Фотоэлектрические процессы и процессы токопереноса при фотостимулированной адсорбции наноразмерного слоя полиэтиленimina на поверхность Si CO Слоем SiO_2 . *Козловский А.В., Маляр И.В., Стецюра С.В.*

26. Комплексные исследования ТФС мультиферроиков $\text{Bi}_{1-x}\text{M}_x\text{FeO}_3$ (M - La, Pr, Nd, Sm). *Гаджиев Г.Г., Омаров З.М., Бакмаев А.Г., Амирова А.А., Абдуллаев Х.Х., Резниченко Л.А., Хазбулатов С.В.*
 27. Исследование электрофизических и механических характеристик тонких пленок вольфрама, легированного титаном. *Голишников А.А., Костюков Д.А., Шевяков В.И.*
 28. Люминесценция в нестехиометрическом три-(8-оксихиноляте) галлия. *Аккузина А.А., Козлова Н.Н., Аветисов Р.И., Аветисов И.Х.*
 29. Теплоемкость нанокристаллического феррита висмута. *Каллаев С.Н., Омаров З.М., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х.*
 30. Десорбция фрагментов органических пленок под действием лазерного излучения. *Туриев А.М., Бутхузи Т.Г., Цидаева Н.И.*
 31. Электрохимическое взаимодействие лития с наночастицами феррита висмута. *Магазинская Е.В.*
 32. Получение и структурный анализ нанопорошков интерметаллидов гольмия и никеля. *Кушхов Х.Б., Маргушева М.М., Карданова Р.А., Борукаева И.А.*
 33. Интерметаллические соединения гольмия и алюминия. *Кушхов Х.Б., Карданова Р.А., Маргушева Х.М., Кяров А.А., Борукаева И.А.*
 34. Фазовые переходы в ферромагнитном композите $\text{Zn}_{0.1}\text{Cd}_{0.9}\text{GeAs}_2 + 10\text{wt.}\% \text{MnAs}$ и $\text{Zn}_{0.1}\text{Cd}_{0.9}\text{GeAs}_2 + 15\text{wt.}\% \text{MnAs}$ при высоком давлении до 7 ГПа. *Арсланов Р.К., Залибеков У.З., Федорченко И.В.*
 35. Влияние деформации и отжига на анизотропию магнитосопротивления теллура. *Абакаров С.А., Абакарова Н.С.*
 36. Влияние примеси CdSe на термо-ЭДС и удельную электропроводность соединения PbTe. *Калмыков Р.М., Кармоков А.М., Мамеев М.В.*
 37. Кинетика электропереноса в боратно-бариевом стекле С78-5. *Кармоков А.М., Молоканова О.О., Шомахов З.В., Кармоков М.М.*
 38. Исследование диэлектрической проницаемости стекол электронной техники в переменном электрическом поле. *Шомахов З.В., Кармоков А.М., Молоканова О.О., Кармоков М.М.*
- Стендовые доклады
39. Особенности формирования гибридных магнитных материалов на основе полифеноксазина и наночастиц магнетита. *Озкан С.Ж., Карпачева Г.П.*
 40. Исследование поверхностной сегрегации в твердых растворах Ag – 0.5 ат. % Bi, Ag – 0.5 ат. % Pb методом ЭОС. *Этуев А.В., Гергов В.З., Шаев З.М., Тхаголегов Р.М., Хамоков А.К., Дышекова Р.А.*
 41. Наноструктурированные межслоевые поверхности в кристаллах типа Ti (Se₂,Te₂) и Bi₂Te₃<Fe>. *Багиров С.Б., Кахраманов К.Ш., Мустафаева К.М.*
 42. Фото- и термостимулированная проводимости в кристаллах CdS<K>. *Матиев А.Х., Хамидов М.М., Бокова З.Г.*
 43. Особенности фото- и термостимулированной проводимости в кристаллах ZnSe <Ag>. *Матиев А.Х., Хамидов М.М., Камурзоева Х.Р.*

44. Фото- и термостимулированная проводимости в кристаллах ZnSe/Bi. *Матиев А.Х., Хамидов М.М., Кациев М.А.-В.*
45. Фотолюминесценция пленок фталоцианинов металлов осажденных из растворов различных растворителей. *Березов А.В., Каркусова О.Д., Туриев А.М.*
46. Поляризация пленок танталата стронция-висмута при легировании ниобием. *Голосов Д.А., Завадский С.М., Мельников С.Н., Колос В.В., Окоджи Д.Э., Тонконогов Б.А.*
47. Влияние катализаторов на газовую чувствительность металлооксидных пленок. *Рембеза С.И., Кошелева Н.Н., Колесникова Н.А.*
48. Исследование фотоэлектрических свойств гетероструктур металлооксид-кремний. *Рембеза С.И., Свистова Т.В., Мокроусов Н.С., Просветов Р.Е.*
49. О динамике вращающейся наночастицы в ближнем поле поверхности толстой пластины. *Елеев А.Р., Кумыков А.З., Фидаров В.И.*
50. Энергетические потери электронного пучка вблизи поверхности графена. *Кумыков А.З., Фидаров В.И., Елеев А.Р., Хутов А.А.*
51. АСМ-метрология рельефа тестовых структур кремния. *Хутов А.А., Кунтишев М.М.*
52. Исследование влияние наноалмазов на структуру и физические свойства полимеров. *Курбонов Н.Б., Курбонов Ч.Б.*

31 мая, среда

09:30 Экскурсия. Ущ. Адыл-Су, ущ. Шхельда, ледн. Шхельда (ледн. Улыбка), нарз. источник Адыл-Су.

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 2. Технология наноматериалов для электроники

Председатели: **Рембеза Станислав Иванович** – д.ф.-м.н., проф., Воронежский государственный технический университет, Воронеж
Кармоков Ахмед Мацевич – д.ф.-м.н., проф., Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

Устные доклады

1. Многослойные структуры для одномерных фотонных кристаллов на основе наноструктурированного оксида алюминия. *Козырев Е.Н., Филоненко В.И., Беляева Т.Н., Гордеев Г.О., Кодзасова Т.Л.*
2. Исследование влияния температуры электролита на характеристики анодного пористого оксида алюминия. *Филоненко В.И., Беляева Т.Н., Гордеев Г.О., Аскеров Р.О.*
3. Functionalization of WS₂ Nanoparticles by Ga Implantation using Focused Ion Beam. *Alex Laikhtman, Meltem Sezen.*

4. Математическая модель синтеза пористого оксида алюминия. *Асланов М.А., Наниева Д.В., Наниев Ф.В.*
5. О корреляции между фрактальной размерностью и коэффициентом пропускания оптической поверхности монокристаллического германия. *Самсонов В.М., Капдунов И.А., Талызин И.В., Дьякова Е.В., Кузнецова Ю.В.*
6. Нелинейная модель барьера шоттки и расчет ВАХ в составной модели токопереноса диодов на основе SiC и его твердых растворов. *Алтухов В.И., Санкин А.В., Сигов А.С., Сысоев Д.К., Филиппова С.В., Янукян Э.Г.*
7. Технологические аспекты создания радиационно-стойких фотопроводящих структур с органическим монослойным покрытием, содержащим металлические наночастицы, на примере сульфида кадмия и арахината свинца. *Стецюра С.В., Харитонова П.Г.*
8. Электрические свойства и морфология гибридной структуры на основе кремния при изменении режима фотоадсорбции молекул органического пассивирующего покрытия. *Козловский А.В., Маляр И.В., Стецюра С.В.*
9. Изменение морфологии поверхности пленок фталоцианина марганца лазерным излучением. *Эсенов Р.С., Рамонова А.Г., Туриев А.М.*
10. Влияние материала подложки на разделение пластин со сформированными СВЧ МИС на основе GaN. *Иванова Н.Е., Трофимов А.А., Щаврук Н.В.*
11. Исследование влияния низкоэнергетического рентгеновского облучения на электрофизические свойства межфазной границы Al – Si. *Калмыков Ш.А., Каров Б.Г., Лосанов Х.Х.*
12. Бессвинцовые припои на основе олова для пайки алюминия, полупроводников, керамик. *Елекоева К.М., Касумов Ю.Н., Лесев В.Н., Манукянц А.Р., Созаев В.А.*

Стендовые доклады

13. Модель адсорбции атомов кавитационными пузырьками и сферическими частицами в алюминии. *Кармокова Р.Ю., Кармоков А.М., Рехвиашвили С.Ш.*
14. Электропроводящие полимерные композиты на основе полиэтилена высокой плотности и технического углерода. *Борукаев Т.М., Гаев Д.С., Бойко А.Н., Шилов В.Ф., Тимошенков С.П., Казадаева Е.В., Ибрагим А.С.*

1 июня, четверг

09:30 Экскурсия. Гора Чегет, оз. Донгуз-Орун-Кёль.

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 3. Приборы и устройства микро- и нанoeлектроники, микросистемная техника

Председатели: **Гуляев Александр Михайлович** – д.ф.-м.н., проф., Московский энергетический институт, Москва

Каргин Николай Иванович – д.т.н., проф., Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Устные доклады

1. Ограничения пиковой мощности наносекундных передатчиков на лазерных диодах с использованием лавинных переключателей. *Земляков В.Е., Егоркин В.И., Вайнштейн С.Н., Маслевцов А.В., Wurz М.С., Филимонов А.В.*
 2. Спектральная плотность мощности шума как метод неразрушающего контроля фотоприемников. *Мирошникова И.Н., Мирошников Б.Н., Баринов А.Д., Попов И.А.*
 3. Исследование характеристик барьера Шоттки на нитриде галлия в процессе обработки в хлорной плазме. *Желаннов А.В., Селезнев Б.И.*
 4. Применение технологии ионной имплантации для формирования приборов на основе GaN. *Федоров Д.Г., Селезнев Б.И., Желаннов А.В.*
 5. Исследование особенностей газочувствительности пленок графена на карбиде кремния. *Григорьев М.Н., Житяев И.Л., Светличный А.М., Спиридонов О.Б.*
 6. Роль Ti в сплавных композициях омического контакта к гетероструктурам AlGaIn/GaN. *Славовский Д.Н., Павлов А.Ю., Павлов В.Ю., Клековкин А.В.*
 7. Специфика пьезоизмерения толщины тонких пленок в процессе нанесения на жидкофазной стадии роста. *Родионов Ю.А., Григорук Н.А.*
 8. Обеспечение прецизионности ионно-оптической системы многоапертурного ионно-лучевого источника. *Родионов Ю.А., Курапова А.А.*
 9. Лактатный биосенсор на основе планарного электрода. *Родионов Ю.А., Кривко Ю.А.*
 10. Сравнение частотных характеристик СВЧ-транзисторов, изготовленных на основе сплавных и несплавных омических контактов к нитридным гетероструктурам. *Павлов В.Ю., Павлов А.Ю., Славовский Д.Н., Зуев А.В.*
 11. Автоэмиссионные дисковые структуры на основе графена на SiC. *Житяев И.Л., Светличный А.М., Спиридонов О.Б., Терещенко В.В., Григорьев М.Н.*
 12. Терморезистивные структуры на основе материала с природной наноструктурой. *Бондарев Д.А., Карачинов В.А., Евстигнеев Д.А., Карачинов Д.В.*
- Стендовые доклады
13. Морфология и состав фоточувствительных элементов на основе халькогенидов свинца. *Мирошников Б.Н., Баринов А.Д., Мирошникова И.Н., Варлашов И.Б., Зенова Е.В.*
 14. Влияние влажности на параметры резистивных газовых сенсоров на основе нанокристаллических пленок оксида олова с аддитивами тербий и сурьма. *Гуляев А.М., Сарач О.Б., Котов В.А., Кобзев А.И., Петров А.Д.*
 15. Особенности построения оборудования для исследования токов абсорбции в диэлектриках. *Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Демидов О.Ю.*
 16. Схемотехническое и технологическое моделирование тонкопленочного транзистора на основе металлооксидов ZnO и SnO₂ в САПР TCAD. *Плотникова Е.Ю., Арсентьев А.В., Винокуров А.А.*

17. Электролюминесцентные панели с повышенной яркостью. *Гончаров И.Н., Малдзигати А.И., Засев Я.Г., Кабышев А.М.*
18. Многощелочные фотокатоды для электронно-оптических преобразователей. *Гончаров И.Н., Жуков А.В., Малдзигати А.И., Еманова Ю.С. Пицхелаури Д.З.*
19. Формирование с высокой точностью структурных слоев микроэлектронных приборов. *Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г.*
20. О моделировании процессов при формировании микроэлектронных приборных структур. *Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г.*
21. Получение методом вакуумного напыления автоэмиссионных слоев на пироэлектрике. *Кармоков А.М., Молоканов О.А., Нагоев Б.Н., Хатукаев Х.М., Кармокова Р.Ю.*

2 июня, пятница

09:30 Экскурсия. Поляна Азау, Новый Кругозор, гора Эльбрус

14:00 Обед

15:00 Дневное заседание (конференц-зал ЭУНК КБГУ)

Секция 4. Информационные технологии в микро- и нанoeлектронике

Председатели: **Рагимов Садияр Садияр Солтанович** – д.ф.м.н., проф.,
Институт физики Национальной Академии наук Азербайджана

Тешев Руслан Шахбанович – д.т.н., проф., зав. каф. электроники и информационных технологий КБГУ, Нальчик

Устные доклады

1. Программный модуль для расчета диффузионных характеристик в приповерхностном слое по данным ЭОС. *Бжыхатлов К.Ч., Хуштов И.А., Болотоков Р.В.*
2. Программный модуль для проведения количественного оже-анализа. *Бжыхатлов К.Ч., Ногов А.В., Нарожнов В.В., Хуранов С.З.*
3. Экспертные системы технологических процессов микро и нанoeлектроники. *Замятин Н.В.*
4. Молекулярно-динамическое моделирование эпитаксиального роста пленок золота и серебра на поверхности тугоплавкого металла. *Бембель А.Г., Самсонов В.М., Васильев С.А.*
5. The economically profitable nanotech investment project is the aspect of the level of economic development of the region. *Karmokova H.V.*
6. Creation of highly science-intensive production facilities, materials and electronic products - a nanotech way to solve the most important problems in the formation of investment attractiveness of regions. *Karmokova H.V.*
7. Интеллектуальная система искусственного освещения растений в защищенном грунте. *Карамурзов Б.С., Каздохов А.Д., Кармоков А.М., Молоканов О.А.*
8. Система управления многозональным агросветильником. *Карамурзов Б.С., Каздохов А.Д., Кармоков А.М., Молоканов О.А., Гуденко Ю.А.*

Круглый стол: Достижения и перспективы развития микро- и нанотехнологий в электронике.

Награждение победителей конкурса молодых ученых, аспирантов и студентов.

Обсуждение проекта и принятие Решения конференции.

Закрытие конференции.

3 июня, суббота

Отъезд участников конференции.